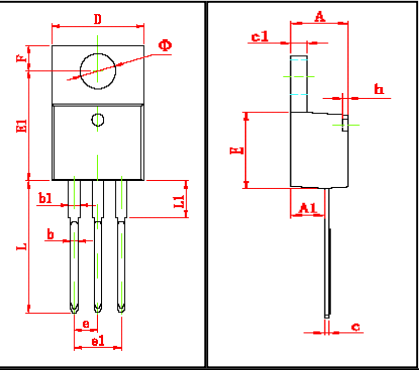


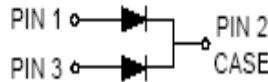
## MBR1040CT - MBR10100CT

### 10A 高电压肖特基势垒二极管

肖特基二极管是以金、银、钼等贵金属为阳极，以N型半导体材料为阴极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。属于低压、低功耗、大电流、超高速半导体功率器件。其 $T_{rr}$ （反向恢复时间）极短（可小到几ns），正向导通压降小，而整流电流却可达几百A至几kA。这些优良特性是快恢复二极管及超快恢复二极管所不具备的，它适合作为开关电源中的低压整流管，微波检波器和混频器等。



Symbol	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.470	4.870	0.176	0.194
A1	2.540	2.820	0.099	0.111
b	0.710	0.910	0.028	0.036
b1	1.170	1.370	0.046	0.054
c	0.310	0.530	0.012	0.021
c1	1.170	1.370	0.046	0.054
D	10.010	10.310	0.394	0.406
E	8.500	8.900	0.335	0.350
E1	12.080	12.480	0.475	0.491
s	2.540 TYP		0.100 TYP	
e1	4.980	5.180	0.196	0.204
F	2.580	2.880	0.102	0.114
h	0.000	0.300	0.000	0.012
L	13.400	13.800	0.528	0.543
L1	3.560	3.960	0.140	0.156
phi	3.735	3.935	0.147	0.155



#### 封装形式说明

见左图表格

电参数最大额定值(测试环境 $T=25^{\circ}\text{C}$  除非特殊说明)

产品特性	符号	MBR 1040CT	MBR 1060CT	MBR 10100CT	单位
最大反向阻断电压	VRRM VRWM	40	60	100	V
平均输出电流 $T_c = 100^{\circ}\text{C}$	IO	10			A
正向最大不重复浪涌电流 8.3ms 半波正弦波 (JEDEC Method)	IFSM	150			A
正向压降 @ $I_F = 5.0\text{A}, T_c = 125^{\circ}\text{C}$ @ $I_F = 5.0\text{A}, T_c = 25^{\circ}\text{C}$ @ $I_F = 10\text{A}, T_c = 125^{\circ}\text{C}$ @ $I_F = 10\text{A}, T_c = 25^{\circ}\text{C}$	VFM	0.59 0.64 0.74 0.85	0.65 0.71 0.77 0.95	0.75 0.8 0.8 0.97	V
最大反向漏电流 @ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$  额定直流电压 @ $T_c = 125^{\circ}\text{C}$	IRM	0.02  20			mA
结间电容	Cj	300			pF
电压转变速率	dV/dt	10,000			V/s
工作储存温度范围	Tj, TSTG	+170; -65 TO +170			$^{\circ}\text{C}$

打印规格说明

MBR 10 100 CT

JT 0731

MBR 产品编码  
10 额定电流  
100 额定电压  
CT 产品编码  
JT 生产公司编码  
0731 生产周期XXYY